⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

®公開特許公報(A)

平3-93344

(3) Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)4月18日

1/028 H 04 N

В

9070-5C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

画像読取装置 会発明の名称 頭 平1-229340 21)特 願 平1(1989)9月6日 22出

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社 久 和 藤 安 明 者 (元)発

海老名事業所内

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社 紀 Ш $\mathbf{\Xi}$ 者 明 ⑪発

海老名事業所内

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社 夫 雅 者 舟 \mathbb{H} 明 ⑪発

海老名事業所内 東京都港区赤坂3丁目3番5号

富士ゼロツクス株式会 人 願 の出

社

清孝 弁理士 阪本 個代 理人

明 細 普

1. 発明の名称

画像読取装置

2. 特許請求の範囲

第1の基板上に形成された受光素子と、第2の 基板上に透明電極、発光層、不透明電極の順て形 成したEL発光素子とを絶縁部材を介して対向す るよう配置し、前記EL発光紫子から発光する光 が反受光素子側に配置された原稿の値で反射し、 その反射光を前記受光素子へ導く光透過窓が前記 不透明電極に設けられた画像読収装置において、

前記EL発光素子と前記絶縁部材の間に絶縁性 の遮光膜を少なくとも前記光透過窓部分を除いて 設け、前記艳緑部材の側面に艳緑性の遮光膜を設 けたことを特徴とする画像説収装置。

3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はファクシミリやスキャナ等に用いられ る画像読取装置に係り、特に分解能を向上させる ためのEL発光・受光素子一体型の価値読収装置 に関する。

(従来の技術)

従来のファクシミリヤスキャナ等には、光原と してEL発光素子を用いるものがおり、特にEL 発光業子と密管型イメージセンサとを一体化した 俎小型の画像読取装置が提案されている。

この画像読取装置は、例えば第3図に示すよう に、ガラス、セラミック等から成る基板1上に形 成された受光素子2と、ガラス等の透明部材から 成るEL基板11上に形成されたEL発光素子4 とを、通光性を行する絶縁部材3で結合させて構 成されるもので、図の表異方向(主走査方向)に 長尺状に形成されている。

受光素子2は、基板で上に第3図の表異方向に 複数配列されるようクロム(Cr)等で形成され た例別電極21と、アモルファスシリコン(a~ S1) で形成された光専電層22と、酸用インジ ウム・スズ (ITO) で形成された透明電極公当 とから成る。

EL発光素子はは、EL基板11上にしての、

1n, O,、SnO,等から構成される透明電極41と、Y,O,、Sl,N。BaTiO,等から成る絶縁値42と、ZnS:Mn等から成る発送値43と、同上の絶縁値42と、アルミニウム(Al)等の金属から成る不透明電極44とを順次積層して成る。透明電極41と不透明電極44とをを光層43から光が放射され、原稿100に照射される。また、プラテンローラ101の回転により、原稿100が移動する仕組みとなっている。

前記不透明電極44には、受光素子2の各受光部分に対応するよう方形状の光透過窓45が開口され、発光図43から発光した光が原稿100で反射し、その反射光が光透過窓45を通過して受光素子2の受光部分へ照射するような構成となっている(特開昭59-210664号公報参照)。(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のような画像統収装置の構 成では、不透明電極44で光透過窓45を通過す る反射光以外の光を一応遮光しているものの、E

荷を出力させて正確な画情報を得ることのできる 画像読取装置を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記従来例の問題点を解決するため本発明は、 第1の基板上に形成された受光素子と、第2の基 板上に透明電極、発光層、不透明電極の顧で形成 したEL発光層子とを絶縁部材を介して対向する よう配置し、前記EL発光素子から発光する光が 反受光素子側に配置された原稿の面で反射し、そ の反射光を前記受光素子の過激が前記で 透明電極に設けられた画像読取装置において、前 記EL発光素子と前記能縁部材の間に絶縁性の 記EEL発光子と前記能縁部材の間に絶縁性の 光膜を少なくとも前記光透過窓部分を除いて設け、 前記能縁部材の側面に絶縁性の避光機を設けたこ とを特徴としている。

(作用)

本意明によれば、EL発光・受光素子一体型の 画像読取装置において、少なくともEL発光素子 の不透明電極に設けられた光透過窓を除き、EL 発光素子と絶縁部村の間に絶縁性の遮光機を形成 L 基板11の端面部および E し発光素子4の端部 において過光が成されていないため、EL発光光 がEL基板11内あるいはEL発光素14円で反 射して迷光となり、当該迷光がEL允光案了4の 不透明電極44と受光業子2の基板1の間を反射 して受光素子2の受光部分に入射することもある し、また画像読収装置の外部からの人射光が受光 素子2の受光部分に人別することもある。例えば、 第 3 凶に示すように、発光光×が原稿 1 ()()に反 射して光透過窓45を通過して受光器子2の受光 部分に入射するのはよいが、発光光yのように光 透過窓45を通過しないで迷光となり、受光紫子 2の受光部分に入射するもの、また、画像読取装 置の外部からの入射光ェが受光素子2の受光部分 に入射するものもあった。そうなると、変光素子 2において、正確な電荷を出力することができな いとの問題点があった。

し、EL発光素子と受光素子の間に形成された絶 報部材の側面をも絶縁性の遮光膜で覆うような構 成にしたので、EL発光光の迷光が光透過窓以外 の部分より受光素子に入射したり、画像読取装置 の外部から光が受光素子に入射するのを助ぐこと ができる。

(実施例)

本允明の一実施例について図面を参照しながら 説明する。

第1図は、本発明の一実施例に係る画像就収装 置の断面説明図を示し、第2図は、第1図の構成 をその上部から示した平面説明図である。第3図 と同様の構成をとる部分については同一の符号を 付している。

実施例の画像読取装置の構成は、ガラス、セラミック等から成る基板1上に形成された受光素子2とガラスから成るEし基板11上に形成されたEし発光素子4とを、透光性を存する絶縁部村3で結合させるものである。

| 東光ポテ2ラ構成は、基数で上にクロム(Cェ)

等の金属から成り下部の個別電機21が形成され、 その上にアモルファスンリコン(a - S i)から 成る光導電層22が形成され、さらにその上に酸 化インジウム・スズ(LTO)から成る透明電極 23が形成される。

前、ここでは下部の個別電區21は主走立方向に離散的に分割して形成され、透明電極23は帯状の共通電極となるよう形成されることにより、光母電層22を個別電極21と透明電極23とで挟んだ部分が各受光素子2を構成し、その集まりが受光素子アレイを形成している。また、離散的に分割形成された個別電極21の端部24は駆動用IC (図示せず)に接続され、受光素子2で生成されてなっている。また、受光素子2において、アモルファスシリコンの代わりに、CdSe(カドミウムセレン)等を光母電筒3とすることも可能である。

E L 発光素子 4 は、E L 基版 1 1 上に I T O、 I n, O, 、S n O, 等から構成される透明電極 4 1 が形成され、その上に Y, O, 、S i, N.、

膜12が形成される。また、絶縁性遮光膜12は E1基板11と絶縁部材3の間にも形成されて、 それぞれを遮光している。さらに接合された画像 読取装置について、E1基板11と絶縁部材3の 側面を関うように、絶縁部材3の側面部に長尺方 向に沿って遮光性封止樹脂13、13を形成する。

次に、この画像統取装置の製造方法について説 明する。

この画像読取装置は、受光素子2部分とEL発 光素子4部分をそれぞれ別々に作製し、これらを 接合して形成するものである。

まず、受光素子2の製造方法は、ガラスまたは セラミック等で形成された基板1上の全面にクロム (Cェ) を脊膜し、この上にレジストを塗布する。マスクパターンを用いて前記レジストを露光、現像してレジストパターンを形成し、エッチングした後にレジストパターンを除去して下部地極となる個別電極21を形成する。そして、P-CVD法によりアモルファスンリコンを資膜し、フォトリン法によるCF、許を用いたブラズマエッチ BaTiO, 等から成る絶縁圏42と、かきに2nS:Mn等から成る発光層43が形成され、またその上に絶縁圏42と、アルミニウム(AI) 若の金属から成る不透明専電機44とを順次積層している。

前記不透明能極44には、受光素予2の各受光部分に対応するよう方形状の光透過寒45が開口され、発光層43から発光した光が原稱100で反射し、その反射光が光透過寒45を通過して没光素子2の受光部分へ照射するような構成となっている

更に、画像読取装置は、上記受光素子2の上に上記E1発光素子4をE1基版11が外側になるよう透光性を行する絶縁部材3で粘合し、侵光器子2とE1発光素子4とを電気的に絶縁している。この場合、E1発光素子4と絶縁部材3との間に、光透過窓45部分を除いてE1発光素子4全体を置うように絶縁性遮光酸12を設ける。つまり、不透明電極44、絶縁層42、発光層43および透明電極41の側面を覆うように絶縁性遮光

ング、またはメタルマスクによるパターニング巻 着により前記個別電極2の先端部分を取う帯状の 光導電M22を形成する。次に、スパックリング 法により酸化インジウム・スズ(1 TO)を習帳 し、フォトリソ法による混骸を用いたウエットエッチングにより前記個別電極2 1 の先端部分を買い、a - Siの光導電M2 2 を挟むよう受光素子 2の透明電極2 3 を形成する。

次に、EL発光素子4の製造方法は、カラス等で形成したEL基板 1 1 上に 1 T O、 1 n, O、 S n O , 等をスパッタ注または蒸音で質膜して発光素子の透明電極 4 1 を形成し、この透明電極 4 1 を形成し、この透明電極 4 1 を形成し、部経 個 4 2 上にスパック法、電子ピーム法等で 2 n S : M n 等を着膜して洗練 が の発光 随 4 3 を F 成し、再度前記同様の地経 M の金属を蒸むし、フォトリン法によりパクーニングして光透過 8 4 5 を 有する 不透明 地 4 4 を 1 成してEL 允光素子 4 を 1 ソナる。この光透過

窓45は、予め、EL発光素子4と受光素子2と が接合した場合に受光素子2の受光部分に対応し で設けられている。これにより、EL発光光が原 桶100を照射し、その反射光が光透過窓45を 透過して受光素子2の受光部分に入射する構成と なっている。

そして、不透明電腦44と絶縁即材3の間に光 透過窓45部分を除いてEL発光素子4を買うよ うに絶縁性遮光膜12を形成する。

この場合、透明電極41と不透明電極44に一 定の電圧を受光紫子2の基板1側から供給するために、第2図の不透明電極44側から見たEL発 光素子4の平面説明図に示すように、図中の両端 部にそれぞれ2箇所の接続端子部を方形状との両端 よう絶縁性遮光膜12を除去して、接続端子3 よう絶縁性遮光膜12を除去して、接続端子3 などけたのは、一箇所からの電荷の供給では透れ を設けたのは、一箇所からの電荷の供給では透れ を設けたのはである。このが正式がによってEL発光 を設けたのはであるが、両端部分から電荷の 光光の輝度にむらが生じるが、両端部分から電荷を 代給することで、その輝度むらを低減させるため

1 側から電荷が透明電極4 1 と不透明電極4 4 に それぞれ供給されるよう接続端子部に電源が接続 されている。

そして、EL基板11の両側面、絶縁部材3の 両側面を遮光性封止樹脂(信越化学工業製:KJ R9050)で覆うよう塗布し、遮光性封止樹脂 膜13を形成する。また、同一の遮光性封止樹脂 を用いて駆動用ICを保護するため駆動用ICの 上からコーティングすることも可能である。本実 版例では、Eし基仮11の側面からの入射光を防 ぐために、EL基板11の筒側面をも遮光性封止 樹脂で重って遮光したが、EL基板11の側面に 遮光性目止樹脂が塗布されていなくても、絶縁部 材3の側面を遮光しているのであれば、画像読取 装置の外部から受光素子2に余計な光を入射させ ることはない。すなはち、EL発光素子4の側面 およびEL基板11と絶縁部材3との間で光透過 窓45以外から光が入射するのを助ぐ構造であれ ばよい。また、本実施例では絶縁性遮光膜12に 光透過窓45に対応する位置を開口したが、絶縁 である。

また、絶縁性遮光膜12の形成方法は、EL能光素子4における不透明電極44の受光素子2側の面にEL発光素子4の全体を取うように絶縁性避光膜材料(Brewer Science社製DARC)をコーティングし、当該犯縁性進光 臓材料を200℃でプリベークしてごりないシストロートし、その後レジストロートし、その後レジストラーンを形成するためにマスクパターンを用いレジストを間めて、第2図に示すパターンを形成するためにマスクパターンを用いレジストを超光・現像し、絶縁性遮光膜材料をエッチングと接続端子部の後、洗浄し、レジスト刻離して、過去する。その後、洗浄し、レジスト刻離して、過去する。その後、洗浄し、レジスト刻離して、過去する。その後、洗浄し、レジスト刻離して、過去する。その後、洗浄し、レジスト刻離して、絶縁性遮光膜材料をファイナルベークして光透過と接続端子部14部分を除いた絶縁性遮光膜12が形成される。

これから、受光案子2の上にEL基板11が外側になるようEL発光案子4を透光性を有する絶縁部材3を介して接合する。絶縁性遮光膜12に形成された接続端子窓14の開口を通して、基板

性遮光機12の中央部に全ての光透過窓45が含まれるような長方形状の一つの間口を設けてもよい。

次に、本発明に係る一実施例の画像結取装置の 駆動方法について説明すると、EL発光素子4に おいて、透明電極41と不透明電極44間に±2 00 V程度の交流電圧が印加されると、透明電極 41と不透明電極44に挟まれた発光層43から EL発光光が発光し、プラテンローラ101によ つてEL基板11上に送られてきた原稿100を 照射し、その反射光が光透過窓45を透過して、 受光素子2の受光部分に入射する。すると、受光 累子2が光に反応して電荷を発生させ、駆動用1 Cの類額によって画情報を信号として出力する。

本実施例によれば、少なくとも光透過窓45の部分を除き、EL発光業子4と受光素子2の間に 絶縁性遮光膜12を形成し、EL基板11の両側面、絶縁部材3の両側面を同じく絶縁性の遮光性 封止樹脂膜13で置うようにしているので、第3 図の従来例で示したEL発光光yがEL基板11 内あるいはEL発光素子4内を収削して迷光となり、当該迷光が光透過窓45以外から受光素子2の受光部分に入射するのを防ぐことができ、また、絶縁性の遮光性針止樹脂膜13の存在によって、調像読取装置の外部から離れ込む光ェを遮光できるため、不要な光入射による誤った読み取りをなくし正確な電荷を出力させて正確な画情報を得ることができる効果がある。

(発明の効果)

本発明によれば、少なくともEL発光素子の不透明電極に設けられた光透過窓を除き、EL発光器子と艳緑部材の間に絶縁性の遮光膜を形成し、EL発光素子と受光素子の間に形成された絶縁部材の側面をも絶縁性の遮光膜で覆うような構成にしたので、EL発光光の迷光が光透過窓以外の部分より受光素子に入射するのを防ぐことができ、不要な光入射による誤った続み取りをなくし、正確な電荷を出力させて正確な面情報を得ることができ、画像読取装置の精度を高める効果がある。

44……不透明電極

45光透過窓

100…原稿

101…ブラテンローラ

出 順 人 富士ゼロックス株式会社 (大理人 弁理士 阪 本 清 孝立)

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の画像競取装置の一头機例の断面説明図、第2 図は第1 図のEL発光素子の平面説明図、第3 図は成果の画像競取装置の断面説明図である。

11 ·· ·· E L 基板

12……絕緣性遮光膜

13 · · 逸光性封止切胎膜

14……接続端子器

2 受光素子

21……個別電腦

22……光導電腦

23……透明電極

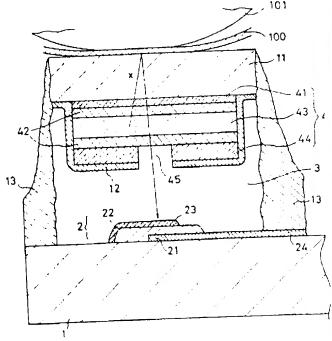
3 接近層

4 E L 殖光素子

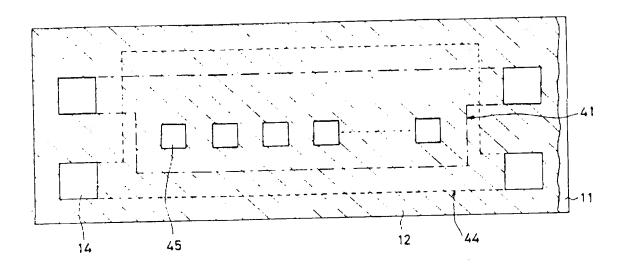
41……透明電極

4 3 … … 発光層

第 1 图



第 2 图



第3图

